

高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 三塚 岳 2020年 9月 10日

光モニター = 光を用いたビーム診断装置

- 光源:加速された荷電粒子が放射する電磁波(可視光,紫外線,X線...)
 - シンクロトロン放射(放射光)
 - 光学的遷移放射
- 光学測定技術:
 - 結像光学系
 - 干涉計
- 光センサー:
 - CCD/CMOSイメージセンサー (通常のカメラ, 高速ゲートカメラ~O(nsec))
 - ストリークカメラ (高時間分解能~100 fs)
 - 光電子增倍管, *半導体検出器*
- 診断対象:
 - ビームサイズ
 - プロファイル
 - 時間構造

 【 ビームサイズ (CCD/CMOS/Si, >1 μm)

バンチ長 (ストリークカメラ, > O(1 mm))

ビームサイズモニターへの要求

- 加速器が想定する最小ビームサイズを測定できる

 - ILCではσ<1 umを要求している
 - SuperKEKBではσ_{min}~10-20 um
- ビームサイズの変動を動的(バンチ毎)に測定できる
 - 静的に精度よく測るのももちろん重要だが…
 - 入射直後はエミッタンスが大きい
 - 電子雲効果などによりビームサイズの増大が起こる
- 安定稼働
 - 結局は故障がなく環境変化に強いモニターが喜ばれる
 - ハードとソフトの両方が重要

代表的な光モニター

角直径 (視直径)



Ζ

距離(z)の位置から対象物を見た時 の見かけの大きさを、その対象物の 直径(d)を見込む角度(θ)で表した値

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left(\frac{d}{2z} \right) \approx \frac{d}{z}$$

手法	波長 [nm]	測定可能な最小ビーム サイズ (角直径 [µrad])	100m離れた地点での 光像のサイズ (μm)	1000m離れた地点での 光像のサイズ (μm)
可視光 結像系	500	5	500	5000
可視光 干渉計	500	0.47	47	470
X線 ピンホール	0.1	0.5	50	500
X線 マルチスリット	0.1	0.1	10	100
X線 FZP	0.35	0.3	30	300
X線 干渉計	0.1	0.01	1	10



● 放射光を用いたビームサイズモニターに焦点を絞って議論。

SuperKEKB X線ビームサイズモニターを例に挙げる。

● シンクロトロン放射(放射光発生機構)と光学(回折)の基礎を学ぶ。

SuperKEKBにおけるX線強度とスペクトラムを実際に計算。

● ビームサイズモニターを運用する上での注意点を学ぶ。

ビームサイズ測定の原理



3. 光の太さを種々の検出器で測定

(ひとまずエミッタンスを無視すると) 測定した光の太さ→発光点での光の太さ≒ビームの太さ(ビームサイズ)



1. 光(電磁波)の発生

「1.光(電磁波)の発生」の目次

- シンクロトロン放射を定性的に理解する
- シンクロトロン放射強度の式を解析的に導出する
- SuperKEKBのX線放射強度とスペクトラムを計算

シンクロトロン放射

(1) 電荷eを持つ
(2) 光速に近い速度で運動している (v~光速度c)
(3) 加速度運動している

ときに放出する電磁波をシンクロトロン放射と呼ぶ。



1947年にGEのシンクロトロン で初めて観測された



[NSLS, Brookhaven]



[Lawrence Berkeley National Laboratory]

SuperKEKBのシンクロトロン放射







中性子星の近くで発生した高エネルギー電子が強磁場中を移動 ハッブル(可視光) + チャンドラ(X線)





- 波長
- 空間的な広がり (3次元的な広がり, 方向)
- 時間的な広がり (パルス性)

シンクロトロン放射強度 放射強度スペクトラム [K.-J. Kim, AIP conf. proc. 184, 565] $\frac{d^2 N_{\rm ph}}{I_{\odot}} = 1.33 \times 10^{13} E^2 \,[{\rm GeV}^2] I_b [{\rm A}] H_2(\omega/\omega^*) \frac{1}{\rm S}$ $\operatorname{photons}$ $\operatorname{s}\operatorname{mrad}^2(0.1\%\,\mathrm{BW})$



[Mulyani et al, NIM A 919, 1]

その他の性質を定性的に眺めたあと、上式の導出を試みる。





[Attwood, AST210/EECS213, UC Berkeley]





電子と一緒に移動している人から見た場合 実験室でシンクロトロン放射を見た場合



実験室系へのLorentz変換 $\mathbf{k}_{\parallel} = \gamma(\mathbf{k}'_{\parallel} + \boldsymbol{\beta}\omega'/c)$ $\mathbf{k}_{\perp} = \mathbf{k}'_{\perp} = \frac{k'\sin\theta'}{\gamma k'\cos\theta' + \gamma \beta k'} \rightarrow \frac{1}{\gamma \beta} (\theta' = \pi/2)$ $\boldsymbol{k}_{\perp} = \mathbf{k}'_{\perp}$ $\boldsymbol{\beta} \approx 1, \ \gamma \gg 1 \ \boldsymbol{\xi} \ \boldsymbol{\psi} \quad \boldsymbol{\theta} \approx \frac{1}{\gamma} \approx \frac{m}{E_{\text{beam}}}$

シンクロトロン放射の広がり角と波長



観測する立場による時間の進みの違い





観測者から見た電磁波の時間分布



SuperKEKB電子ビームの場合



$$\gamma \approx rac{7}{0.000510} = 13700$$

 $a = 106 \,\mathrm{m} \,$ だから
 $\omega_0 = c/a = 2.8 \,\mathrm{MHz}$
を代入すると
 $\Delta t \approx rac{3}{2\omega_0 \gamma^3} \approx 2 \times 10^{-19} \,\mathrm{sec}$

まとめ:シンクロトロン放射の性質





空間的な広がり → 前方に集中、θ~1/γ

● 時間的な広がり
$$\Delta tpprox rac{3}{2\omega_0\gamma^3}$$

これより放射強度の式を導出する。

放射強度導出の流れ (Lienard-Wiechert)

今回はこちらの解説はしません。 下に挙げた教科書などをご参照下さい。

Schwinger, Phys. Rev. 75, 1912 (1949) Jackson, Classical Electrodynamics 砂川, 理論電磁気学 池田, OHO 2004など



一般的な方法 (多くの教科書に載っているが計算が面倒)

1.運動する電荷からカレントを計算

2.カレントを積分してLieanrd-Wiechertポテンシャル(ψ, A)を求める 3.ポテンシャルを微分-∇ψ-∂A/∂tしてLienard-Wiechert場(E)を求める 4.Eをフーリエ変換して周波数に分解する

5. |E(ω)|²から周波数ごとの放射エネルギーが求まる

放射強度導出の流れ (Heaviside-Feynman)

Heaviside-Feynman方程式を使う方法 (見通し良し) Feynman, Lectures on Physics (II)

Feynman, Lectures on Physics (II) Wang, Phys. Rev. E 47, 4358 (1993) Zangwill, Modern Electrodynamics

1.運動する電荷が作る電場Eを直感的に求める
 2.Eをフーリエ変換して周波数に分解する
 3.[E(ω)]²から周波数ごとの放射エネルギーが求まる

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^2} + \frac{R_{\text{ret}}}{c} \frac{d}{dt} \left(\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^2} \right) + \frac{1}{c^2} \frac{d^2 \boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{dt^2} \right] \begin{bmatrix} 1項目 : \boldsymbol{\mathcal{I}} - \boldsymbol{\mathcal{I}} \boldsymbol{\mathcal{I}} \boldsymbol{\mathcal{I}} \boldsymbol{\mathcal{I}} \\ 2項目 : 等速運動 \rightarrow 1/R^2 \\ 3項目 : 加速度運動 \rightarrow 1/R \end{bmatrix}$$

「Lienard-Wiechert = Heaviside-Feynman」の証明は[Wang, Phys. Rev. E 47, 4358]を参照。

$$1+2\bar{\mathbf{\eta}} \exists \mathbf{\eta} = \frac{1+2\bar{\mathbf{\eta}}}{R^2} + \frac{R}{c} \frac{d}{dt} \frac{\mathbf{n}}{R^2} = \frac{\mathbf{n}}{R^2} \frac{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}} + \frac{R}{c} \frac{d\tau}{dt} \left[\frac{d\mathbf{n}}{d\tau} \frac{1}{R^2} - \frac{2\mathbf{n}}{R^3} \frac{dR}{d\tau} \right] \\ = \frac{1}{R^2(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta})} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta}) + \mathbf{n}(1+\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta})].$$
(9)
$$3\bar{\mathbf{\eta}} \equiv \frac{3\bar{\mathbf{\eta}}}{R} \frac{1}{c} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta})}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}} - \frac{1}{R^2} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta})}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}} - \frac{1}{R^2} \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta})}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}} \frac{dR}{d\tau} \right] \\ = \frac{1}{R^2(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta})} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta}) + \mathbf{n}(1+\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta})].$$
(9)

The Nobel Prize in Physics 1965



Photo from the Nobel Foundation archive.

Sin-Itiro Tomonaga

Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.

Julian Schwinger

Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.

Richard P. Feynman

Prize share: 1/3

余談:量子電磁力学の道のりについては

「著作権保護コンテンツ」



運動する電荷が作る電場E



Heaviside-Feynmanの式

$$\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{r},\,t\right) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_{0}} \left[\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^{2}} + \frac{R_{\text{ret}}}{c}\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{R_{\text{ret}}^{2}}\right) + \frac{1}{c^{2}}\frac{d^{2}\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{dt^{2}}\right] \rightarrow \frac{e}{4\pi\varepsilon_{0}}\frac{1}{c^{2}}\frac{d^{2}\boldsymbol{n}_{\text{ret}}}{dt^{2}} \left(R \gg \gamma\lambda\right)$$

- ・左辺:位置Pで時刻tに観測した電場E
- 右辺1項目:時刻t_{ret}におけるクーロン場
- ・右辺2項目:時刻tretにおけるクーロン場の時間変化率 x 伝搬時間R/cだけ外挿
- ・右辺3項目:時刻tretにおける方向ベクトルの二階時間微分だから加速度運動



各周波数における放射エネルギー強度

放射エネルギー ≈ 電磁波振幅の二乗 ≈ 電場の二乗 $\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\varepsilon_0 cR^2}{\pi} \left[\frac{E(\omega)}{2} \right]^2 R_{\text{ret}} \varepsilon \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \left[I = \frac{dU}{d\omega}, P = \frac{dU}{dt}, \frac{d^2P}{d\Omega d\omega} = \frac{d^2U}{d\Omega d\omega} \frac{I_b}{e} = \frac{dI}{d\Omega} \frac{I_b}{e} \right]$ Heaviside-Feynmanの式 周波数に分解した電場 = E(t)のフーリエ変換の加速度運動の項 $E(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt E(t) \exp(i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{c^2} \frac{d^2 n_{\text{ret}}}{dt^2} \exp(i\omega t)$ E(\omega)をdI(\omega)/dΩに代入すると $\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{e^2 R^2 \omega^4}{16\pi^3 c^3 \varepsilon_0} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \boldsymbol{n}_{\rm ret} \exp(i\omega t) \right|^2 \qquad \Box \Box \boldsymbol{J}_{\rm t}$

"時刻(tret)における放射点"から"観測者"へ向く方向ベクトルnretをフーリエ変換
→ 放射エネルギーの周波数スペクトラム

つまり方向ベクトルnretが分かれば、 nret内でtret→tと変数変換すれば良い。

方向ベクトルnretを求める



方向ベクトルnretを求める

$$\begin{split} r_{0}(t_{\rm ret}) &= a[1 - \cos(\omega_{0}t_{\rm ret})]\hat{x} + a\sin(\omega_{0}t_{\rm ret})\hat{z} \\ r &= r\sin\theta\hat{y} + r\cos\theta\hat{z} \quad (\phi = \pi/2) \\ \mathcal{O}$$
時に $\theta \approx 0, \ t_{\rm ret} \approx 0$ で近似すると

$$|\mathbf{R}_{\rm ret}| &= |\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}(t_{\rm ret})| \approx r - a\omega_{0}t_{\rm ret} \\ \mathbf{R}_{\rm ret}| &= |\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}(t_{\rm ret})| \approx r - a\omega_{0}t_{\rm ret} \\ \mathbf{R}_{\rm ret}| &= |\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}(t_{\rm ret})| \approx r - a\omega_{0}t_{\rm ret} \\ \mathbf{R}_{\rm ret}| &= \frac{\mathbf{R}_{\rm ret}}{|\mathbf{R}_{\rm ret}|} \approx \frac{a[\cos(\omega_{0}t_{\rm ret}) - 1]\hat{x} + r\sin\theta\hat{y} + [r\cos\theta - a\sin(\omega_{0}t_{\rm ret})]\hat{z}}{r - a\omega_{0}t_{\rm ret}} \\ \mathcal{O}\left(\frac{a}{r}\right), \ \mathcal{O}(\theta), \ \mathcal{O}\left(t_{\rm ret}^{2}\right)$$
まで残して展開し、tretが掛からない項を除くと

$$\mathbf{n}_{\rm ret} \approx \frac{a}{r} \left[-\frac{1}{2}\omega_{0}^{2}t_{\rm ret}^{2}\hat{x} + \theta\omega_{0}t_{\rm ret}\hat{y}\right] \\ \text{が得られる。ここまでは幾何学の計算。} \end{split}$$

Av

※1 数値計算の場合は近似することなくr, r₀(t_{ret})を直接入力してn_{ret}を計算 ※2 Lienard-Wiechertよりも数値計算速度が幾分早い

ここまでのまとめ

放射エネルギー ≈ 電磁波振幅の二乗 ≈ 電場の二乗

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{\varepsilon_0 cR^2}{\pi} |E(\omega)|^2 R_{\rm ret} を簡易表記$$
Heaviside-Feynmanの式
周波数に分解した電場 = E(t)のフーリエ変換
 $E(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt E(t) \exp(i\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{c^2} \frac{d^2 \mathbf{n}_{\rm ret}}{dt^2} \exp(i\omega t)$
E(ω)をdI(ω)/d Ω I=代入すると

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{e^2 R^2 \omega^4}{16\pi^3 c^3 \varepsilon_0} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \mathbf{n}_{\rm ret} \exp(i\omega t) \right|^2$$
 $r_0(t_{\rm ret}) = a[1 - \cos(\omega_0 t_{\rm ret})]\hat{x} + a\sin(\omega_0 t_{\rm ret})\hat{z}$
 $r = r \sin\theta \hat{y} + r \cos\theta \hat{z} \ (\phi = \pi/2)$
Ano様な状況だと
 $n_{\rm ret} \approx \frac{a}{r} \left[-\frac{1}{2} \omega_0^2 t_{\rm ret}^2 \hat{x} + \theta \omega_0 t_{\rm ret} \hat{y} \right]$
Nret 0 中のtret をtへ変換する。
33

t_{ret}→tへ変数変換

 n_{ret} の中の t_{ret} をtへ変換する (フーリエ変換がtに対してなので)。 $t_{ret} = t - R(t_{ret})/c$ に $R_{ret} = r - r_0(t_{ret})$ を代入する。(分母ではないので $|R_{ret}| = |r - r_0(t_{ret})| \approx r - a\omega_0 t_{ret}$ はだめ)

tretの3次方程式を解く

Cardanoの公式 $x^3 + px + q = 0$

の解は

$$x = \left(-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}\right)^{1/3} + \left(-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}\right)^{1/3}$$

で求まる。

この枠組みに収まる様に、以下の変数変換

$$\eta = 3\gamma^{2}(1+\gamma^{2}\theta^{2})^{-3/2}\omega_{0}t, \xi = \frac{\omega}{2\omega^{*}}(1+\gamma^{2}\theta^{2})^{3/2}, \omega^{*} = \frac{3}{2}\gamma^{3}\omega_{0} \quad (\omega t = \xi\eta)$$
を行うと
 $(\omega_{0}t_{ret})^{3} + \frac{3(1+\gamma^{2}\theta^{2})}{\gamma^{2}}\omega_{0}t_{ret} - 6\omega_{0}t = 0$
の解は 左辺はtret 右辺はtの関数であるη
 $\omega_{0}t_{ret} = \gamma^{-1}\sqrt{1+\gamma^{2}\theta^{2}}\left((\sqrt{\eta^{2}+1}+\eta)^{1/3}-(\sqrt{\eta^{2}+1}-\eta)^{1/3}\right)$
となり、めでたくt_{ret}→tの変数変換が可能になる。

Fourier積分の計算 → 放射強度

 $\omega t = \xi \eta$ で置き換え 放射強度の式へnret(tretの関数)を代入した $\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{e^2 R^2 \omega^4}{16\pi^3 c^3} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{a}{r} \left[-\frac{1}{2} \omega_0^2 t_{\text{ret}}^2 \hat{\boldsymbol{x}} + \theta \omega_0 t_{\text{rec}} \hat{\boldsymbol{y}} \right] \exp(i\omega t) \right|^2$ の 右辺の tret を $\omega_0 t_{\rm ret} = \gamma^{-1} \sqrt{1 + \gamma^2 \theta^2} \left((\sqrt{\eta^2 + 1} + \eta)^{1/3} - (\sqrt{\eta^2 + 1} - \eta)^{1/3} \right)$ で置き換えると、Fourier積分の \hat{x} と \hat{y} に掛かる項は $\int_{0}^{\infty} d\eta \left[\left(\sqrt{\eta^{2} + 1} + \eta \right)^{1/3} - \left(\sqrt{\eta^{2} + 1} - \eta \right)^{1/3} \right]^{2} \cos(\xi \eta) = \left| \frac{2}{\sqrt{3\xi}} K_{2/3}(\xi) \right| \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{x}} \, \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{n}} \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{x}} \, \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{n}} \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{n}} \hat{\boldsymbol{n$ $\int_{0}^{\infty} d\eta \left[\left(\sqrt{\eta^{2} + 1} + \eta \right)^{1/3} - \left(\sqrt{\eta^{2} + 1} - \eta \right)^{1/3} \right] \sin(\xi \eta) = \left| -\frac{1}{\sqrt{3}\xi} K_{1/3}(\xi) \ \hat{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\sigma} \hat{\boldsymbol{y}} \, \boldsymbol{\bar{\rho}} \boldsymbol{\bar{\sigma}} \boldsymbol{\sigma} \, \boldsymbol{\bar{y}} \, \boldsymbol{\bar{\rho}} \boldsymbol{\bar{\sigma}} \boldsymbol{\sigma} \, \boldsymbol{\bar{y}} \, \boldsymbol{\bar{\rho}} \boldsymbol{\bar{\sigma}} \boldsymbol{\bar{\sigma}} \, \boldsymbol{\bar{\eta}} \, \boldsymbol{\bar{\eta}} \, \boldsymbol{\bar{\sigma}} \, \boldsymbol{\bar{\eta}} \, \boldsymbol{\bar{\eta}} \, \boldsymbol{\bar{\sigma}} \, \boldsymbol{\bar{\eta}} \,$ と変形Bessel関数で表せる。 $R \approx r$ と近似すると最終的には放射強度

$$\frac{dI(\omega)}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3e^2\gamma^2}{4\pi^2c} \left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)^2 (1+\Theta^2) \left[(1+\Theta^2)K_{2/3}^2(\xi) + \Theta^2 K_{1/3}^2(\xi) \right]$$

が得られる。
ここまでの計算の個人的見解

•近似が非常に多い。
$$\left(\beta \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2}, r \gg a, \theta \ll 1\right)$$

●現実的には近似が成り立つとは限らない → 調べるのも難儀。

数値を求めるだけならば、実際の状況に基づいてnretを求め、
 Lorentz変換、Fourier変換、代数計算…等と数値計算で放射強度を求めた方が楽な場合がある。

とは言え、モニターする現象を理解する、さらに数値計算プログラムを書く上で理論の流れを知っておく(目で追う)のは重要。

補講:観測者の位置を一般化
これまでの計算

$$r_0(t_{ret}) = a[1 - \cos(\omega_0 t_{ret})]\hat{x} + a\sin(\omega_0 t_{ret})\hat{z}$$

 $r = r\sin\theta\hat{y} + r\cos\theta\hat{z}$ ($\phi = \pi/2$)
 $\xi \equiv \upsilon \tau$
 $z = l = l \oplus \hat{y} + r\cos\theta\hat{z}$ ($\phi = \pi/2$)
 $\xi \equiv \upsilon \tau$
 $z = l = l \oplus \hat{y} + r\cos\theta\hat{z}$ ($\phi = \pi/2$)
 $\xi \equiv \upsilon \tau$
 $r = r \sin\theta\hat{y} + r\cos\theta\hat{z}$ ($\phi = \pi/2$)
 $\xi \equiv \upsilon \tau$
 $r = r \cdot r_0(t_{ret})$
 $r = r \cdot r_0(t_{ret})$







[Mitsuhashi et al., IBIC 2017]





[Mitsuhashi et al., IBIC 2017]



放射強度 → 放射する光子の数

熱量(watt)を計算する場合は"放射強度 dl/dΩ"の式が便利。 一方、"放射される光子の数 dN/dΩ"で表現した方が便利な場合も多い。

dN _	$dI \Delta \omega$	
$\overline{d\Omega}$ –	$\overline{d\Omega} \ \overline{\hbar\omega}$	
	e^2	$3\gamma^2 \Delta \omega (\omega)^2 (1+\Theta^2) \left[(1+\Theta^2) K^2 (\zeta) + \Theta^2 K^2 (\zeta) \right]$
	$-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\hbar\omega}$	$\frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{\omega^*}\right) \left(\frac{1+0}{\omega^*}\right) \left[\frac{1+0}{\omega^*}\right] \left[\frac{1+0}{\omega^$

最初の項は微細構造定数αと置き換えられる

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \left(=\frac{1}{137}\right)$$

電子軌道の真ん前からシンクロトロン放射を眺めると $\Theta = \gamma \theta \to 0 \ (\theta \to 0)$ $\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)^2 \left(1 + \Theta^2\right) \left[(1 + \Theta^2) K_{2/3}^2(\xi) + \Theta^2 K_{1/3}^2(\xi) \right] \to \left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)^2 K_{2/3}^2 \left(\frac{\omega}{2\omega^*}\right) \equiv H_2 \left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)$ $\frac{dN}{d\Omega} \to \alpha \frac{3\gamma^2}{4\pi^2} \frac{\Delta\omega}{\omega} H_2 \left(\frac{\omega}{\omega^*}\right)$ と近似可能。 [Kim, AIP Conf. Proc. 184, 565]

1個の電子が放射する光子の数

大雑把に $\int d\Omega \sim \frac{1}{\gamma^2} \ \& \left\langle \frac{\Delta \omega}{\omega} H_2\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right) \right\rangle \sim \mathcal{O}(1) \ \& \mathbb{E}$ けるので

$$\langle N \rangle \approx \int \alpha \frac{3\gamma^2}{4\pi^2} \left\langle \frac{\Delta\omega}{\omega} H_2\left(\frac{\omega}{\omega^*}\right) \right\rangle d\Omega \sim \alpha$$

のように書ける。

細かい話を無視すると、1個の電子からα= 1/137 = 0.0072の確率で光子が放射される。

または電子が偏向電磁石を横切る事137回に一個の光子が放射されると理解できる。



[Kim, AIP Conf. Proc. 184, 565]

1個の電子が光子を2個放射する確率



2個の電子が放射する光子の数



インコヒーレントな放射

お互いに独立に放射されることを インコヒーレントな放射 と言う。

※コヒーレントな状態 二つの電磁波の位相が揃っている状態 → お互いに干渉

実際に放射光の強度を測定してみると荷電粒子の数n に比例しており(nα)、αのn乗(αⁿ)には比例しないので 、放射はインコヒーレントであることが分かる。

電子ビームが放射する光子の数

光子の放出(電子1個あたり1/137)はすごく少ないように感じるが、 加速器の中を回っているビームの中には膨大な数の荷電粒子がいる ので、実際の放射は非常に強い。

例:0.1 Aの電子ビームでは 0.1 A / 1.66 x 10⁻¹⁹ C = 6 x 10¹⁷ / secも電子がいる

ビームエネルギーE (GeV)とビーム電流Ib (A)で光子数を記述すると

 $\frac{d^2 N_{\rm ph}}{d\Omega} = 1.33 \times 10^{13} E^2 \left[\text{GeV}^2 \right] I_b [\text{A}] H_2(\omega/\omega^*) \frac{\text{photons}}{\text{s} \, \text{mrad}^2 \left(0.1\% \, \text{BW} \right)}$

SuperKEKBにおけるシンクロトロン放射
下の式にビームエネルギーE (GeV)とビーム電流lb (A)を代入すれば良い
$$\frac{d^2 N_{\rm ph}}{d\Omega} = 1.33 \times 10^{13} E^2 [\text{GeV}^2] I_b [\text{A}] H_2(\omega/\omega^*) \frac{\text{photons}}{\text{s} \operatorname{mrad}^2(0.1\% \text{ BW})}$$

 Table 3.2: XRM beamline parameters in Phase 1 commissioning of SuperKEKB.

able 0.2. Attai beamine parameters			sioning of bup			4.0	$\times 10^{11}$
Parameter		LER (e^+)	HER (e^-)	Unit		10	HER Ec= 7.2 keV
Radius of source bend	ρ	31.85	105.98	m	.1%BW	8	B HER
Distance from source to optic Distance from optic to Be window	L L'	9.47 31.79	10.26 32.69	m m	/mA/C	6	6
Thickness of Be filter		0.5	16	mm	ad ²		
Thickness of Be window		0.2	0.2	mm	/mr	4	LER Ec= 4.4 keV
Thickness of Au		200	200	μm	s/su		
Thickness of Diamond		600	600	μm	otoi	2	2
Air gap		10	00	mm	РЧ		
Effective thickness of YAG:Ce		14	41	μm		0	0 10 20 30 40 50
							Photon energy [keV]

[Mulyani et al, NIM A 919, 1]

2. 光の伝搬

「2.光の伝搬」の目次

- ピンホール・マルチスリットを用いたビームサイズ 測定を概観する
- Maxwell方程式からKirchhoff回折公式を導く
- Fresnel回折近似とFraunhoffer回折近似を導く

ピンホールによる垂直ビームサイズ測定 w 重ね合せ d₁ a_2 86668889

光源

検出器

ビームサイズが有限 = 光源が点ではなく垂直方向に分布(ガウス分布と仮定)

ピンホール(スリット)

"任意のガウス分布(No)に従う光源"が作る"検出器上での光子分布"→ "点光源が作る検出器上での光子分布"を"ガウス分布(NR)に従って重ね合わせ"

ピンホールによる垂直ビームサイズ測定

[Mulyani, Ph.D thesis]

 $N_O \leftrightarrow N_R$ の対応が事前に分かっていれば、 N_R を測定して N_O を導出可能。

58

Slit width [µm]

Heisenbergの不確定性原理より

 $\Delta y \Delta p_y \ge \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta d = \frac{\downarrow}{2\Delta y} \left\langle \begin{array}{c} \downarrow \\ - \downarrow \end{array} \right\rangle$

$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$ $\Delta p_y = \Delta(p\sin\theta) = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}\Delta\theta$

[Attwood, AST210/EECS213, UC Berkeley]

だから、回折限界と呼ばれる関係が得られる。

$$\Delta d\Delta \theta \geq \frac{\lambda}{2\pi}$$

Δpyの項は

スリット幅(Δd)をどんなに狭めても、スリット通過後の角度不定性 (Δθ)が大きくなり、結局小さなビームサイズを測定出来ない。 (カメラの小絞りボケと同じ現象, F値を一定以上大きくしても逆にぼやける)

単純なマルチスリットの欠点 2500 1um もはやガウス分布ではないので 25µm 50µm ガウスフィットは意味がない 2000 100um 150um 200µm Encodeされた像から元の像を再現す 300µm 1500 450µm choton/pixel る方法: 1. Deconvolution → フーリエ変換 1000 2. Correlation (下記) → 線形代数 500 簡単に表すとRは R = OA120 20 40 60 80 100 140 [Mulyani, Ph.D thesis] pixel RからOを導くには右からGをかけて RG = OAG = Oを満たすGが存在すれば良い。 Aとの掛け算がデルタ関数になる $AG = \delta$ O: Object R: Recoded A: Aperture ようなGを探すのは一般に困難

[Fenimore and Cannon, Applied Optics, 17, 337]

山が重なった測定データの解析手法

Correlation : AG=δを満たすGをR(測定データ)に掛けRG=Oを得る

- 長所:計算が早い → リアルタイム測定に有利
- 短所:精度が悪い → AG=δは完全には満たされない(裾野を引く)
- Fit: O'を変化させR'=O'Aを計算し、R'がRと等しくなるO'を探す
 - 長所:精度が高い → ノイズの影響も比較的正確に考慮できる
 - 短所:計算が遅い → minimum searchなので計算がたくさん必要

SuperKEKBでは現時点では精度を優先して手法2を採用。 フィットに伴う計算時間はマルチCPU計算で短縮化させる。

Correlation法で解析精度を上げるようなマルチスリットパターン = Uniformly Redundant Array (URA) 詳しくは[Fenimore and Cannon, Appl. Opt. 17, 337-347 (1978)]を参照。

一般的に波は回折する

もちろん今回は光(電磁波)の回折に焦点を絞って議論する。

スカラー回折理論とベクトル回折理論

•スカラー回折理論

Lipson, Optical Physics グッドマン, フーリエ光学

- ●遮蔽またはスリットが光の波長に比べて大きい
- 回折した光をスリットから離れた地点で観測
- 光が伝搬する媒質が線型、等方、均一、非分散
- 結果的に光を記述する波動方程式は方向依存性を持たない

・ベクトル回折理論

- ●上記した条件を満たさない場合
- ●物質構造(電気的な境界条件など)を考慮する

今回のビームサイズ光モニターではスカラー回折理論で十分。

Kirchhoff回折公式導出の流れ

1. Maxwell方程式 → 2. 場のスカラー化 → 3. Helmhortz方程式 (波動の伝搬)

Helmhortz方程式を解くと

- ある地点Qで発生し
- 面S1を透過し
- ある地点Pに達した 際のスカラー波を記述できる。

面S1上で間隔bのスリット外側ではス カラー波の振幅が0(つまり波が消える) と置いてKirchhoff回折公式を求める。

Maxwell方程式 → 場のスカラー化

誘電率eが一定で等方的ならばMaxwell方程式から

 $abla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$ $abla^2 H - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$ $(B = \mu H, \ c = 1/\sqrt{\mu \varepsilon})$ が得られる。

(例えば誘電率 ϵ が位置に依存する場合は、Eの式に $\nabla(E \cdot \nabla \ln \sqrt{\epsilon})$ が入る)

EとHを伝搬方向に依存しないスカラー場と置くと、任意のスカラー場 $\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r}) \exp(-i\omega t)$ を導入し、**E**とHをまとめて $\nabla^{2} \Psi$

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 1}{\partial t^2} =$$

 $\mathbf{0}$

と書ける。

Helmhortz方程式

EとHをまとめた式 $\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r}) \exp(-i\omega t)$ $\nabla^2 \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$

からスカラー波の振幅の空間分布を表す偏微分方程式 $abla^2\psi = -rac{\omega^2}{c^2}\psi = -k_0^2\psi$ $\left(rac{\omega}{c} = k_0
ight)$ が得られる。 $(
abla^2 + k_0^2)\psi = 0$

をHelmhortz方程式と呼ぶ。

Helmhortz方程式を使えば「ある点でスカラー波(光)が発生した」という 初期条件の下で「発生点以外の地点へ伝搬した波の振幅」が求まる。

Helmhortz方程式を解く→Green関数法
塩界値付きの偏微分方程式を解く→Green関数法
Helmhortz方程式

$$(\nabla^2 + k_0^2)\psi = 0$$

の特殊解としてGreen関数(補助関数)
 $\psi_t(\mathbf{r}) = \frac{a_t}{r} \exp(ik_0 r)$
を導入し、一般解を ψ と置くと
 $\psi\nabla^2\psi_t - \psi_t\nabla^2\psi = -\psi k_0^2\psi_t + \psi_t k_0^2\psi = 0$
が得られる。
原点を囲む任意の領域Vで積分して、Greenの定理を使うと
 $\iiint_v (\psi\nabla^2\psi_t - \psi_t\nabla^2\psi) dV = \iint_S (\psi\nabla\psi_t - \psi_t\nabla\psi) \cdot ndS$

※原点を電磁波を観測する地点と定義する(発光点ではないことに注意)。

Helmhortz方程式 → Kirchhoffの積分定理

ただし特殊解はr=0では発散するので原点
(r=0)を含む領域Soを除く必要がある。
$$\left[\iint_{S_0} + \iint_{S_1}\right] (\psi \nabla \psi_t - \psi_t \nabla \psi) \cdot ndS = 0$$
r \rightarrow 0という極限を取るとSoの寄与は

 $\iint_{\mathcal{S}_0} a_t \exp(ik_0 r) d\Omega = 4a_t \pi \psi_0$

<u>^</u> <u>^</u>

となる。ここで
$$\psi \rightarrow \psi_0 \ (r \rightarrow 0)$$
 と置いた。

結果的に原点(観測点)での電磁波は

煩雑な計算は教科書参照 Lipson, Optical Physics グッドマン, フーリエ光学

$$\iint_{\mathcal{S}_1} \frac{1}{r^3} \exp(ik_0 r) [\psi(ik_0 r - 1)\mathbf{r} + r^2 \nabla \psi] \cdot \mathbf{n} dS = -4\pi \psi_0$$

で得られる。これをKirchhoffの積分定理という。

Kirchhoffの回折公式を使った数値計算

1.任意の観測点Oを定める。

2.スリットS1の微小空間に対してforループを取る。ループ内でd1とdが決まる。 3.ループの数だけψ0を足しあげる。

▲ S1の分割を細かく取らないと計算が収束しない。


 $\exp\left[\frac{ik_0(x_s^2+y_s^2)}{2z}\right] \approx 1, \ \exp\left[\frac{ik_0(x_o^2+y_o^2)}{2z}\right] \approx 1 \ (z \gg x, \ y)$



Fresnel回折とFraunhofer回折

 $\frac{x_s^2 + y_s^2}{\gamma} \ll \lambda$ が成り立てばFraunhofer領域



回折で判断するピンホールの最良サイズ

Fresnel近似で求めた強度分布I(Z,R)の中心部分I(Z,R=0)をピンホールの面積a²で規格化

 $I'(Z,0) = \frac{I(Z,0)}{a^2} = 4\frac{I_0}{a^2}\sin^2\left(\frac{\pi a^2}{2\lambda f}\right) \quad \text{fltスリットから観測者までの距離} \qquad \boxed{ 久保田, 波動光学}$

ピンホールの半径aを変えながら強度分布I'(Z,0)を見ると $a = \sqrt{\lambda f} \sqrt{\lambda f} / \sqrt{2}$ の間に極大がありそう。



alこ対するI'の微分が0ならばI'の極大に対応するaが求まるので $\frac{dI'(Z,0)}{da} \sim \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin^2 x}{x} \right) = 0 \qquad t t \cup x \equiv \frac{\pi a^2}{2\lambda f} \ t \equiv 0$ この解は $2x = \tan x \ t \ y = 0.37\pi \ t t = 0$ 、これをaで表すと結局 $a^2 = 0.74\lambda f$ が得られる。

回折で判断するピンホールの最良サイズ



3. 光の測定

「3.光の測定」の目次

- SuperKEKB X線モニターの各コンポーネントを解説
- 運転上の注意点を確認
- 水平方向ビームサイズをいかに測定するか



SuperKEKB X線ラインのコンポーネント



偏向電磁石:ビーム軌道を曲げてシンクロトロン放射を起こす

X線フィルター:X線強度を抑制、ビームラインとX線ラインの真空を分離

マスク:シングルスリットやマルチスリットが含まれるCVDダイヤ基板

Be窓:X線ライン真空と検出器箱(He)を分離する

検出器:シンチレーター板+CMOSカメラ、またはシリコン検出器

検出器に写るX線像の数値計算







[Wiedemann, Particle Accelerator Physics]

Critical photon energy E_c



Photon energy [keV]

X線フィルター

フィルターの役割:X線を吸収してライン下流への放射強度を抑制 $\exp(-i\omega t)$:時間発展 電磁波の物質中の伝搬

 $E(r,t) = E_0 \exp(-i(\omega t - kr))$

ここで物質中の屈折率n(ω)を $n(\omega) = 1 - \delta + i\beta$

E

と置くと、波数kは係数δとβの関数となる。

$$\frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} = \frac{c}{1 - \delta + i\beta} \to k = \frac{\omega}{c}(1 - \delta + i\beta)$$

kをE(r, t)に代入すると
$$E(r,t) = E_0 \exp \left[-i\left(\omega t - \frac{\omega}{c}(1 - \delta + i\beta)r\right)\right]$$

 $\exp(ikr)$:空間伝搬

原子散乱因子

$$\delta = \frac{n_a r_e \lambda^2}{2\pi} f_1^0(\omega)$$

 $\beta = \frac{n_a r_e \lambda^2}{2\pi} f_2^0(\omega)$
ただし
 $n_a = \rho/m_a$
 $r_e = 2.8 \times 10^{-15}$ m

吸収

 $\propto f_2^0$

 $= E_0 \exp(-i\omega(t - r/c)) \exp(-i(2\pi\delta/\lambda)r) \exp(-(2\pi\beta/\lambda)r)$

 $\propto f_1^0$

 $f_2^0(\omega)$ が大きい物質をフィルターに使えば効率よく吸収できる。

真空中の時空発展 位相シフト→散乱



SuperKEKBのX線フィルター

SuperKEKBではBe膜を

- •X線窓: ビームラインとX線ラインの真空を分離
- •X線フィルター:X線強度を抑制

の両目的に使用。

フィルター無しだとSiマスク損傷



[Flanagan et al, IBIC2013, wepf15]



SuperKEKBのX線フィルター

Descenter	CesrTA D Line		SuperKEKB	
Parameter			LER	HER
Energy (GeV)	5	.3	4	7
Bend radius (m)	31.65		31.74	106
On-axis solid- angle power density (W/mr ² /A)	2,357		560	2,807
Line power density (W/mr/A)	345		112	313
Distance from source to optics box (m)	4.549		9.39	10.27
Aperture width (mm)	2.38		0.5	0.5
Current (A)	0.200	0.243	3.6	2.6
Be filter thickness (mm)	0	0	0	0 14
Zero-degree area power density (W/mm ²)	23 Ces	28 srTAと	23 同程度の	69 23 9強度とな

厚すぎるフィルターも問題



- Beはフィルターに向いていない (吸収が小さい)。
- ●厚くすると散乱の寄与が目立つ。
- ●将来はCuフィルターも検討。

[Flanagan et al, IBIC2013, wepf15]

マスクの材質

CesrTA (5.3 GeV)で試験

- マスク Si 625 um + Au 19 um
- 200 mA~SuperKEKB e+リング
- •243 mAでX線を直接照射 するとマスクに損傷あり





1064°C < t < 1414°C と予想

- ・マスク CVDダイヤ 350 um + Au 8.7 um
- 多結晶ダイヤ熱伝導率>1000 W/m·K
- 243 mAでX線を直接照射 してもマスクに損傷無し

SuperKEKBではCVDダイヤ基板 600 umを使用(高価だが)。

[Flanagan et al, IBIC2013, wepf15]





X線マスクチェンバー

·上下昇降機構



マスクホルダー用ロッド







●X線窓,フィルター,マスクチェンバーを水冷チラーで冷却。

●チラーが止まるとインターロックが動作(焼け落ち防止、たまに誤報あり)。

X線マスクチェンバーの振動









[増澤, 川本, 2019年12月測定]

- ・主な振動源:東大通り、チラー、遠心装置、関東ローム層
- チェンバーの振動はビームサイズ測定に影響大見かけの像~√(真の像² + チェンバーの振動²)
- ・加速度センサーを用いてXYZ方向の振動を測定
- チラーがかなり大きな振動源だった
- (後に説明する)検出器の露光時間が短ければ影響無し
 → 無いように測定速度を早める

X線マスクチェンバーの振動の影響



- SuperKEKB X線マスクチェンバーは20 Hzで0.2 um、100 Hzで0.01 um
 程度の振動なので、上図を1/10または1/100スケールすれば良い。
- ●CMOSカメラの露光時間 (100 us)では問題にならない。

X線マスクチェンバーの振動の対策





[增澤, 川本, 2020年1月測定]

X線検出器



X線検出器箱の内部レイアウト



検出器箱内のO²パージとHe充填





- X線と大気の散乱・吸収を
 防ぐため検出器箱内をHe
 で満たす。
- ●He流量計とO²濃度計でHe 充填を確認。



シンチレーター + カメラの概略



11 mm

X線がシンチレーターに照射され、その際発光した蛍光を測定

位置分解能	シンチレーター上で11um/pixel x 1000-2000 pixel
強度分解能	12bit ADC (科学計測用では16bitもある)
ダイナミックレンジ	一般的に70-80 dB
S/N比	~50カウント以下@12bit (ほとんど漏れ込んだ光の影響)
高速性	一般的に最短露光時間は30 us (~30 kHz)

CMOS/CCDカメラ



	Basler Ace acA2440- 20gm	IO Industry32B216- CX	Allied Vision Manta G-031	
センサー	Sony CMOS IMX264	Sony CMOS IMX252	Sony CCD ICX618	
ピクセルサイズ	3.45 µm x 3.45 µm	3.45 μm x 3.45 μm	5.6 µm x 5.6 µm	
ダークノイズ	2.3 e-		12.9 e⁻	
ダイナミックレンジ	73.4 dB	73.6 dB	62.4 dB	
S/N比	40.2 dB	40.4 db		
フレームレート (/s)	23 (2448 x 2048 pixs)	167 (2064 x 1544 pixs)	125 (656 x 492 pixs)	
インターフェース	GigE	CoaxPress (BNC)	GigE	

- CCDは~300 Gy、CMOSは~1k Gyでセンサーに異常が出る (出力異常や斑点)。
- センサーが同じならばピクセルサイズやフレームレートは同じ。
- ・読み出しはメーカー謹製のSDK(C/C++,無料が多い)を使うか、LabViewと連携。

シンチレーターの材質

	ρ / g/cm ³	ħω / eV	λ _{max} / nm	yield / 1/keV	n@ λ _{max}	R _δ / nm
BGO	7.13	49.9	480	8	2.15	3.95
PWO	8.28	53.3	420	0.1	2.16	3.70
LSO:Ce	7.1	51.3	420	32	1.82	3.85
YAG:Ce	4.55	42.1	550	11	1.82	4.69
LuAG:Ce	6.76	47.8	535	14	1.84	4.12
YSO:Ce	4.45	41.3	420	9.2	1.80	4.78



[Kube et al., IPAC 12, weoaa02]

B. Walasek-Höhne, IBIC 2019, TUBO01

"LuAG:Ceの密度はYAG:Ceに比べて 大きい。"

"CCDカメラ1pixelあたりの光量は LuAG:CeがYAG:Ceに比べて1.5倍大 きい。"

[Tous et al., NIM A 591, 264–267]

SuperKEKBでは主に LuAG:Ce → HER (電子7 GeV) YAG:Ce → LER (陽電子4 GeV) と使い分け。

- ●密度が大きいLuAG:Ceの方がX線像 がシャープになる。
- LERは放射強度が小さいので、シリコン検出器までより多くのX線を透過させるためYAG:Ceを使用。

シンチレーターの厚み



●SuperKEKBではこれまで100um厚を使用。

●ちなみに50um厚も持っているが扱いが大変なので未使用のまま。

実際のデータ (電子リング 7 GeV)



実際のデータ (陽電子リング 4 GeV)



シンチレーターの汚れの影響



シリコンストリップ検出器 (開発中)



測定したいのはバンチ毎のビームサイズ
 (電子雲等によるビーム不安定の研究に有益)

CMOSカメラで測定できるのは 100 usの積分値 (~10⁴バンチ)



センサーモジュール



シリコンストリップセンサー



シリコンストリップ検出器 (開発中)

- ●高速測定だけなら高速ゲートカメラでも良いが…
- ・
 か射線環境下での長期運転を考えると専用回路が必須。
- ●光モニター用回路は基本的にBelle II TOP検出器のコピー。 シリコンストリップセンサー模式図



[Nishimura, BPAC 2018]

バンチ毎のビームサイズ測定


水平方向ビームサイズ測定

水平方向のビームサイズをどうやって測定するか? (ここでは単純な幾何光学を使って議論)



垂直

水平

100

0

200

200

400

300

(arb

0

Inten.

H. Profile Inten. (arb) ©©©©

(arb

0.

Profil

バンチ内電子の水平方向分布が ガウス分布N(xo, μ, σ)に従うとすると

$$x_2 \approx 0$$
の時
 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{N}(x_0, \mu, \sigma) dx_0 = 1$

$$x_2 \gg 0$$
の時
 $I = \int_{-\infty}^{x_{0R}} \mathcal{N}(x_0, \mu, \sigma) dx_0$
 $= \frac{1}{2} \left(1 + erf\left(\frac{x_{0R} - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \right)$

(erf: 誤差関致)



400

600

500

800

600

水平方向ビームサイズ測定

SuperKEKB Phase 1 (2016.2 - 2016.6)後のマスクホルダー



マスクホルダーのCuロッド部分 (表面) 鉛直上向き → 幅500 um, 深さ2 mmのコリメータ ↓ ↓ X線の跡

電子は水平方向に偏向されるのでシンクロ トロン放射も水平方向に長い分布を持つ



Cuの減衰距離(強度が1/eに落ちる距離)は100 um (ɛ_{ph} = 30keV)。深さ2 mmのCuならばコリメータ に当たったX線はほとんど落とせる。



発光地点の奥行きの影響



発光地点の奥行きの影響



水平方向広がり角の波長依存性 一般化した計算(角度に制限なし) 水平方向の角度: ξ 垂直方向の角度:ψ [Mitsuhashi et al., IBIC 2017, WEPCC09] また $\frac{d^{2}I}{d\omega d\Omega} = \frac{e^{2}}{3\pi^{2}c} \left(\frac{\omega\rho}{c}\right)^{2} \left(\frac{1}{\gamma^{2}} + \psi^{2} + \xi^{2}\right)^{2} \left| K_{2/3}^{2}(\xi) + \frac{\psi^{2}}{\frac{1}{\gamma^{2}} + \psi^{2} + \xi^{2}} K_{1/3}^{2}(\xi) \right| \qquad \zeta = \frac{\omega\rho}{3c} \left(\frac{1}{\gamma^{2}} + \psi^{2} + \xi^{2}\right)^{3/2} E_{1/3}^{2}(\xi)$ 上式を使うと水平方向の角度ξの平均は $\langle \gamma^2 \xi^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty \gamma^2 \xi^2 (d^2 I / (d\omega d\Omega)) d\psi}{\int_0^\infty (d^2 I / (d\omega d\Omega)) d\psi}$ Radiation I pulse $\Delta t \approx \frac{3}{2 \cos^3}$ pulse $\langle \xi \rangle \sim 0.41 \left(\frac{\lambda}{a} \right)^{1/3}$
波長が長いと広 Time がり角が大きい $\lambda \approx c\Delta t$ と得られる。 $a = c/\omega_0$ を代入すると確かに $\langle \xi \rangle \sim 1/\gamma$ という(波長依存を無視した) 関係が得られる。 [Attwood, AST210/EECS213, UC Berkeley]

114

SuperKEKBでの発光地点の奥行きの影響



Matching

- これまでの議論ではビームはx-z平面上を運動し、速度のy成分は0と置いてきた。しかし実際はビーム内の荷電粒子は各々有限の角度を持って運動する。
- ビームの空間的な広がりよりもスリットの広がりが大きい必要がある。



Matching

SuperKEKBのX線発光点では $\alpha = -0.93$ $\beta = 28.0 \,{\rm m}$ だから $\gamma = \frac{1+\alpha^2}{\beta} = 0.036\,/\mathrm{m}$ エミッタンスはデザイン値(SuperKEKB Phase1)を採用して $\varepsilon = 10 \, \mathrm{pm}$ とすれば角度分布の最大値は $\sqrt{\varepsilon\gamma} \approx 2 \times 10^{-7} \,\mathrm{rad}$ これは発光点から40m離れた場所では8 umにしかならない。 SuperKEKB X線モニターはビームの角度広がりもカバーしている。



- SuperKEKB X線ビームサイズモニターを題材に光モニターの基礎を学習。
- シンクロトロン放射の放射強度、空間的・時間的な広がりを求めた。
- Kirchhoffの回折公式からFresnel又はFraunhofer回折を導き、光の回折を 計算出来るようになった。
- ビームサイズモニターを扱う上での注意点を学んだ。



 $m{R}_{
m ret} = m{r} - m{r}_0(t_{
m ret})$ $t_{
m ret} = t - R(t_{
m ret})/c$ Retarded time (遅延時間、遅れた時間)

()

Ζ





注:観測者の方向とx軸は直行するので、ここではDoppler効果は関係ない。